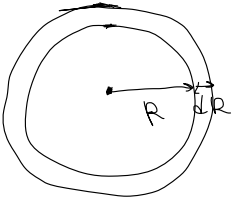


7.18. В центре сферы радиусом R в некоторый момент времени создается N молекул газа, скорости которых имеют максвелловское распределение, соответствующее температуре T . Затем молекулы разлетаются без столкновений и оседают на стенках сферы. Найти плотность j потока молекул вблизи поверхности сферы как функцию времени. Определить момент времени t_0 , когда поток максимален, и найти скорость молекул v_0 , подлетающих к стенке в этот момент.



1) $v = R/t \Rightarrow dv = -\frac{R}{t^2} dt$

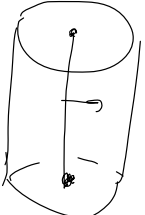
2) $dh = -N \cdot \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot 4\pi v^2 dv \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow N \cdot \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mR^2}{2kTt^2}} \cdot 4\pi \frac{R^3}{t^4} dt$

3) $j = \frac{dn}{S \cdot dt} = \frac{NR}{t^4} \cdot \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mR^2}{2kTt^2}}$

4) $j \rightarrow \max \text{ при } t_0 = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{m}{kT}}, v_0 = 2 \sqrt{\frac{kT}{m}}$

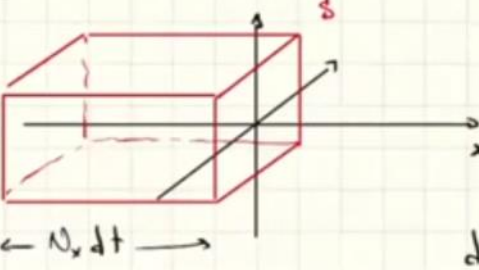
7.14. В диоде электроны, эмитируемые накалившимся катодом, попадают в задерживающее поле анода. До анода доходят лишь достаточно быстрые электроны. Считая, что тепловые скорости эмитируемых (вышедших из катода) электронов распределены по закону Максвелла с температурой $T = 1150$ К, определить долю электронов α , преодолевающих задерживающий потенциал: 1) $V = 0,2$ В; 2) $V = 0,4$ В. Катодом является тонкая прямолинейная нить, натянутая по оси цилиндрического анода.



$f(v) = C \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot 2\pi v dv$

также $p = \frac{\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv}{\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv} = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{kT} \int_{v_0}^{\infty} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} d(v^2) = e^{-\frac{mv_0^2}{2kT}} = e^{-\frac{eV}{kT}}$

7.20. Электроны, движущиеся в тонком поверхностном слое полупроводника, могут рассматриваться как «двумерный» идеальный газ. Вычислить частоту z ударов электронов, приходящихся на единицу длины периметра границы области, в которой заключен этот «газ». Считать при этом заданными температуру T , поверхностную концентрацию частиц n и массу электрона m .



$$v_x \div v_x + dv_x$$

$$n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right) dv_x \quad v_x dS = dN$$

$$d\bar{v}_x = \frac{dN}{dt dS} = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right) v_x dv_x$$

$$\bar{v} = \int_0^{+\infty} n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right) v_x dv_x = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot \frac{kT}{m} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} d\left(\frac{v_x^2}{2} \frac{m}{kT}\right) =$$

$$= n \frac{kT}{m} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left(-e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} \right) \Big|_0^{+\infty} = n \left(\frac{8kT}{\pi m} \right)^{1/2} \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

7.27. Через какое время давление воздуха в тонкостенном откачанном сосуде, в стенке которого имеется отверстие площадью $S = 10^{-6} \text{ см}^2$, возрастает от $P_1 = 10^{-4} \text{ мм рт. ст.}$ до $P_2 = 10^{-2} \text{ мм рт. ст.}$, если давление наружного воздуха $P_0 = 760 \text{ мм рт. ст.}$, а температура 20°C ? Объем сосуда $V = 1 \text{ л.}$ Через какое время давление в сосуде станет равным половине атмосферного давления?

$$p = nkT \quad 1) \quad \frac{dN}{S dt} = 0j = j_{\text{out}} - j_{\text{in}} = -\frac{1}{4} n \bar{v} + \frac{1}{4} n_{\text{out}} \bar{v} = -\frac{1}{4} \bar{v} \left(n + \frac{p_0}{kT} \right)$$

$$2) \quad dN = V dn \quad \rightarrow \quad V dn = \frac{1}{4} \bar{v} \left(\frac{p_0}{kT} - n \right) S dt$$

$$\frac{dn}{\frac{p_0}{kT} - n} = \frac{8}{4V} dt$$

$$\frac{4V}{S} \ln \left(\frac{\frac{p_0}{kT} - n_0}{\frac{p_0}{kT} - n_1} \right) = \tau$$

7.70. Определить, во сколько раз изменится доля молекул водорода, которые имеют скорость, отличающуюся от наиболее вероятной скорости не более, чем на $\pm 3 \text{ м/с}$, при уменьшении температуры газа от 600 К до 400 К ? Газ считать идеальным.

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{v_2^2 e^{-\frac{mv_2^2}{2kT_2}} \cdot \left(\frac{1}{T_2}\right)^{3/2}}{v_1^2 e^{-\frac{mv_1^2}{2kT_1}} \cdot \left(\frac{1}{T_1}\right)^{3/2}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{T_2}}}{\sqrt{\frac{1}{T_1}}} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} \approx 1,2$$

7.16. Электроны, движущиеся в тонком поверхностном слое, могут рассматриваться как «двумерный» идеальный газ. Вычислить для этого газа величину α — отношение наиболее вероятной и среднеквадратичной скоростей.

$$f(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right) \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot 2\pi v dv$$

$$v^* = \sqrt{\frac{kT}{m}} \text{ — наиб. ср. } v$$

$$\rightarrow \frac{v^*}{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{m \langle v^2 \rangle}{2} = E = \frac{1}{2} kT = \left\{ i=2 \right\} = \frac{2kT}{2} \Rightarrow \langle v^2 \rangle = 2kT$$

7.67. В тонкостенном сосуде, содержащем одноатомный идеальный газ при температуре T , имеется небольшое круглое отверстие, через которое атомы газа вылетают в вакуум. Размеры отверстия малы по сравнению с длиной свободного пробега. Атомы газа имеют массу m , и в каждый момент времени их скорость описывается максвелловским распределением. 1) Определить наивероятнейшее значение скорости атомов, покидающих сосуд. 2) Определить среднюю по модулю скорость атомов в пучке, вылетающих из отверстия.

У к а з а н и е. $\int_0^{\infty} x^{2n} \exp(-ax^2) dx = \frac{1}{2a^n} \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$

$$dE = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) \cdot \frac{mv^2}{2} \cdot v_x \, dv_x \, dv_y \, dv_z$$

$$\langle v \rangle = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) \cdot v \cdot v_x \, dv_x \, dv_y \, dv_z$$